

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年8月24日(2006.8.24)

【公開番号】特開2005-79130(P2005-79130A)

【公開日】平成17年3月24日(2005.3.24)

【年通号数】公開・登録公報2005-012

【出願番号】特願2003-304255(P2003-304255)

【国際特許分類】

<i>H 01 L</i>	<i>23/52</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/3205</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 09 F</i>	<i>9/30</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>51/50</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 05 B</i>	<i>33/14</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 05 B</i>	<i>33/26</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>29/786</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 02 F</i>	<i>1/1343</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 02 F</i>	<i>1/1345</i>	<i>(2006.01)</i>

【F I】

<i>H 01 L</i>	<i>21/88</i>	<i>N</i>
<i>G 09 F</i>	<i>9/30</i>	<i>3 3 0 Z</i>
<i>H 05 B</i>	<i>33/14</i>	<i>A</i>
<i>H 05 B</i>	<i>33/14</i>	<i>Z</i>
<i>H 05 B</i>	<i>33/26</i>	<i>Z</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/88</i>	<i>R</i>
<i>H 01 L</i>	<i>29/78</i>	<i>6 1 2 C</i>
<i>G 02 F</i>	<i>1/1343</i>	
<i>G 02 F</i>	<i>1/1345</i>	

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月11日(2006.7.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成される薄膜配線層であって、A1を主成分とする主導体層と該主導体層を覆う被覆層からなり、該被覆層は、(Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W)から選択される1種または2種以上の添加元素を3~15原子%含有し、残部が実質的にNiからなる合金層であることを特徴とする薄膜配線層。

【請求項2】

添加元素は、(V、Nb、Ta)から選択される1種又は2種以上であることを特徴とする請求項1に記載の薄膜配線層。

【請求項3】

添加元素として、少なくともNbを1~7原子%含有し、かつMoおよび/またはWをNbとの合計で3~10原子%含有すること特徴とする請求項1に記載の薄膜配線層。

【請求項4】

ガラス基板上に形成する配線層であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載

の薄膜配線層。